



旅充/移动电源 快充解决方案

公司简介



杭州士兰微电子股份有限公司坐落于杭州高新技术产业开发区，2003年3月公司股票在上海证券交易所挂牌交易（600460），成为第一家在中国境内上市的集成电路芯片设计企业。经过十多年的发展，已从单纯的芯片设计企业发展成为国内少有的IDM（Integrated Device Manufacturer）模式的半导体企业。截至2018年，公司总资产近80亿元人民币。

得益于士兰微的IDM模式，电源产品线经过近十年的技术积累和产品开发历程，结合自主研发的电源工艺平台和数字电源控制技术，在适配器/充电器/移动电源/小家电/白电等领域，持续推出了有竞争力的电源解决方案。自主专利的高压启动/QR控制技术，定制的低热阻封装，多协议的快充支持，自适应的快充保护，为客户提供高集成度、低待机、高效率、高可靠性的电源产品。

旅充快充方案

SDH8671

产品特点

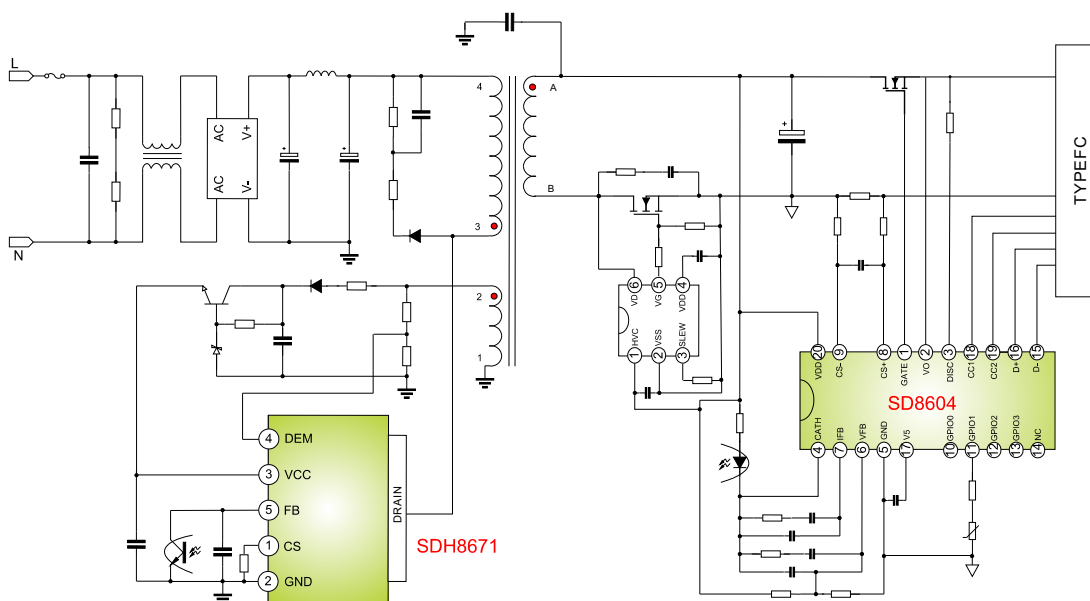
- ◎ SSR架构芯片，工作于CCM/DCM/QR模式
- ◎ 内置高压启动，待机功耗<40mW
- ◎ 内置650V高压DPMOS
- ◎ 改善的抖频方式，有效降低EMI
- ◎ VCC HOLD功能，防止轻载或动态切换时芯片欠压重启
- ◎ 自适应输出OVP，Brown in/out，输出二极管短路保护等完善的保护功能
- ◎ EHSOP5贴片封装

SD8604

产品特点

- ◎ 内置MCU，CV/CC控制
- ◎ 3V~24V工作电压
- ◎ 支持PD3.0/QC3.0/SCP/FCP/Apple/AFC/SFCP等多协议
- ◎ 20mV调压和50mA调流精度
- ◎ 可配置的电流采样放大倍数，适用于高压小电流/低压大电流
- ◎ 驱动NMOS负载开关
- ◎ TSSOP20/QFN5*5封装

典型应用原理图



SDH4875Q

产品特点

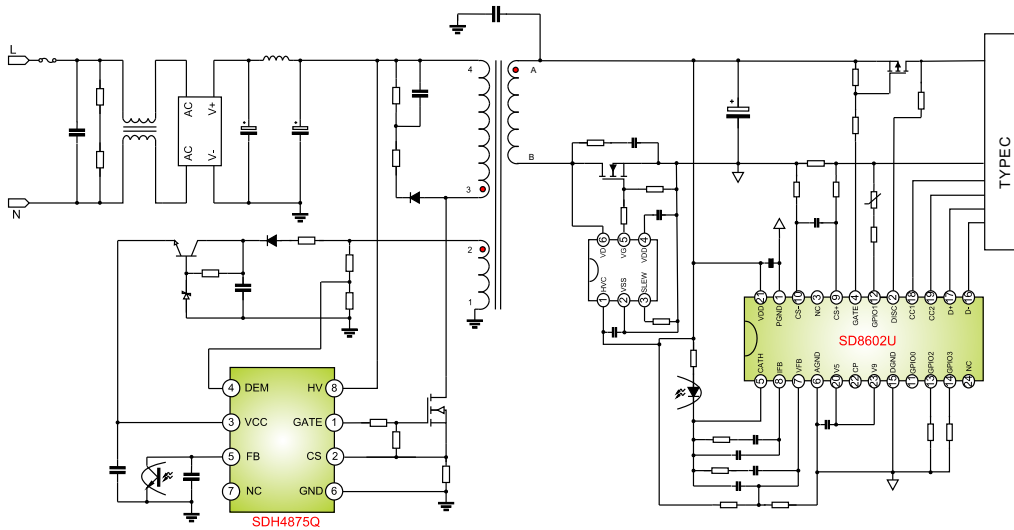
- ◎ SSR架构芯片，工作于CCM/DCM/QR模式
- ◎ 内置高压启动，待机功耗<40mW
- ◎ 改善的QR模式抖频，有效降低EMI
- ◎ VCC HOLD功能，防止轻载或动态切换时芯片欠压重启
- ◎ 自适应输出OVP，Brown in/out，输出二极管短路保护等完善的保护功能
- ◎ SOP8贴片封装

SD8602

产品特点

- ◎ 内置MCU，CV/CC控制
- ◎ 3V~24V工作电压
- ◎ 支持PD3.0/QC3.0/SCP/FCP/Apple/AFC/SFCP等多协议
- ◎ 20mV调压和50mA调流精度
- ◎ 可配置的电流采样放大倍数，适用于高压小电流/低压大电流
- ◎ 包含4-5个GPIO，用于个性化配置
- ◎ 驱动PMOS负载开关
- ◎ SSOP24/QFN5*5封装

典型应用原理图

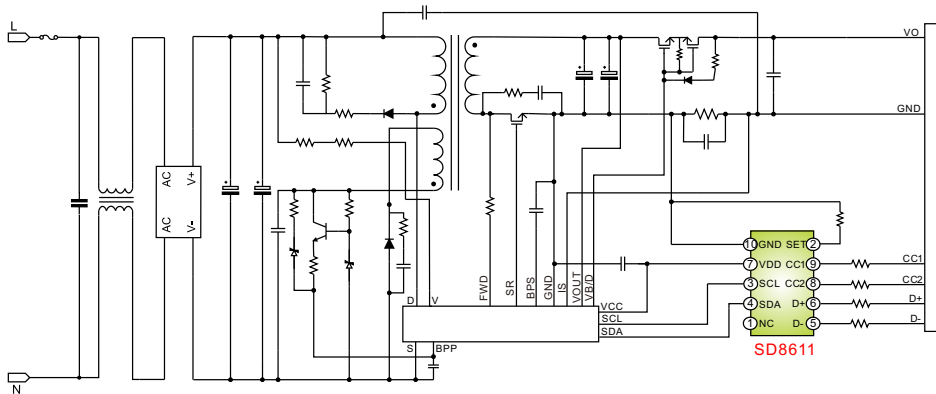


SD8611

产品特点

- ◎ 3-5.5V工作电压
- ◎ 支持PD 3.0/QC3.0/SCP/FCP /Apple/AFC/SFCP
- ◎ 内置MCU
- ◎ 支持I2C通信
- ◎ 可搭配Innoswitch3-pro芯片
- ◎ SSOP10封装，精简的外围设计

典型应用原理图



旅充非快充方案

SDH8594ES

产品特点

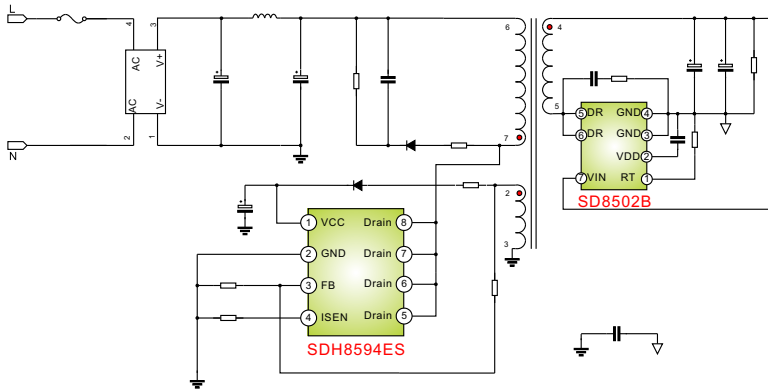
- ◎ PSR架构芯片，工作于DCM模式
- ◎ 内置高压启动，低待机功耗
- ◎ 动态响应佳
- ◎ 内置650V高压MOSFET
- ◎ 内置补偿电容
- ◎ 线损补偿可调
- ◎ 辅助绕组开路等完善的保护功能
- ◎ SOP8贴片封装

SD8502B

产品特点

- ◎ 工作于DCM模式
- ◎ 内置40V低压MOSFET
- ◎ 最小导通时间可调
- ◎ 欠压关断
- ◎ 最小关断时间保护
- ◎ SOP7贴片封装

典型应用原理图



PSR ICs 参数列表

序号	IC型号	输出功率	功率管	Rds(on)	待机功耗	线损补偿	封装形式
1	SDH8592AS	5W	内置MOS	7.2Ω	50mW	可调	SOP7
2	SDH8593AS	8W	内置MOS	5Ω	50mW	可调	SOP7
3	SDH8594AS	10W	内置MOS	2.8Ω	50mW	可调	SOP7
4	SDH8594ES	10W	内置MOS	2.8Ω	50mW	可调	SOP8
5	SDH8595AS	12W	内置MOS	1.8Ω	60mW	可调	SOP7
6	SDH8595AD	12W	内置MOS	3.4Ω	50mW	可调	DIP7
7	SDH8530DS	3.5W	内置BJT	----	50mW	6%	SOP7
8	SDH8530AS	6W	内置BJT	----	50mW	6%	SOP7

SR ICs 参数列表

序号	IC型号	输出功率	工作模式	功率管	功率管耐压	Rds(on)	封装
1	SD8502B	5V/2.1A	DCM	内置MOS	40V	16mΩ	SOP7
2	SD8502	5V/2.4A	DCM	内置MOS	45V	13mΩ	SOP7
3	SD8503	5V/3A	DCM	内置MOS	45V	9mΩ	SOP7

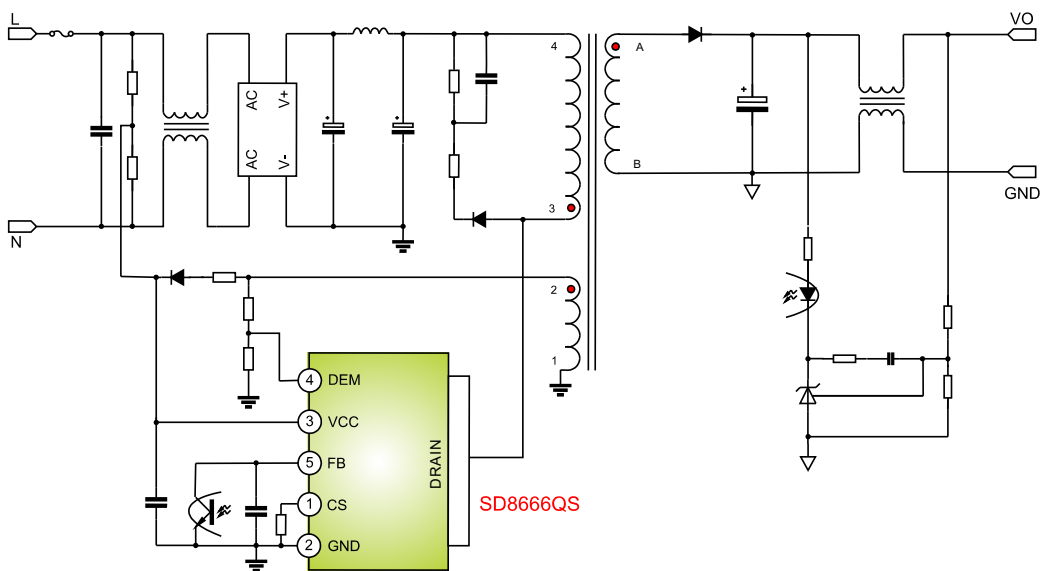
适配器方案

SD8666QS

产品特点

- ◎ SSR架构芯片，工作于CCM/DCM/QR模式
- ◎ 内置650V高压DPMOS
- ◎ 改善的QR模式抖频，有效降低EMI
- ◎ VCC HOLD功能，防止轻载或动态切换时芯片欠压重启
- ◎ Brown in/out，输出OVP，输出二极管短路保护等完善的保护功能
- ◎ EHSOP5贴片封装

典型应用原理图



SSR ICs 参数列表

序号	IC型号	输出功率	功率管	Rds(on)	高压启动	QR	BO	封装形式
1	SDH8665Q	24W	内置MOS	1.6Ω	Y	Y	Y	DIP8
2	SDH8666QS	36W	内置MOS	0.55Ω	Y	Y	Y	EHSOP5
3	SD8666QS	36W	内置MOS	0.55Ω	N	Y	Y	EHSOP5
4	SDH8633	12W	内置MOS	3.4Ω	Y	N	N	DIP8
5	SDH8634	24W	内置MOS	2.5Ω	Y	N	N	DIP8
6	SDH8635	15W	内置MOS	1.6Ω	Y	N	N	DIP8
7	SD4874Q	65W	外置	----	N	Y	Y	SOT23-6
8	SD4873A	65W	外置	----	N	N	N	SOT23-6

SD59B23

产品特点

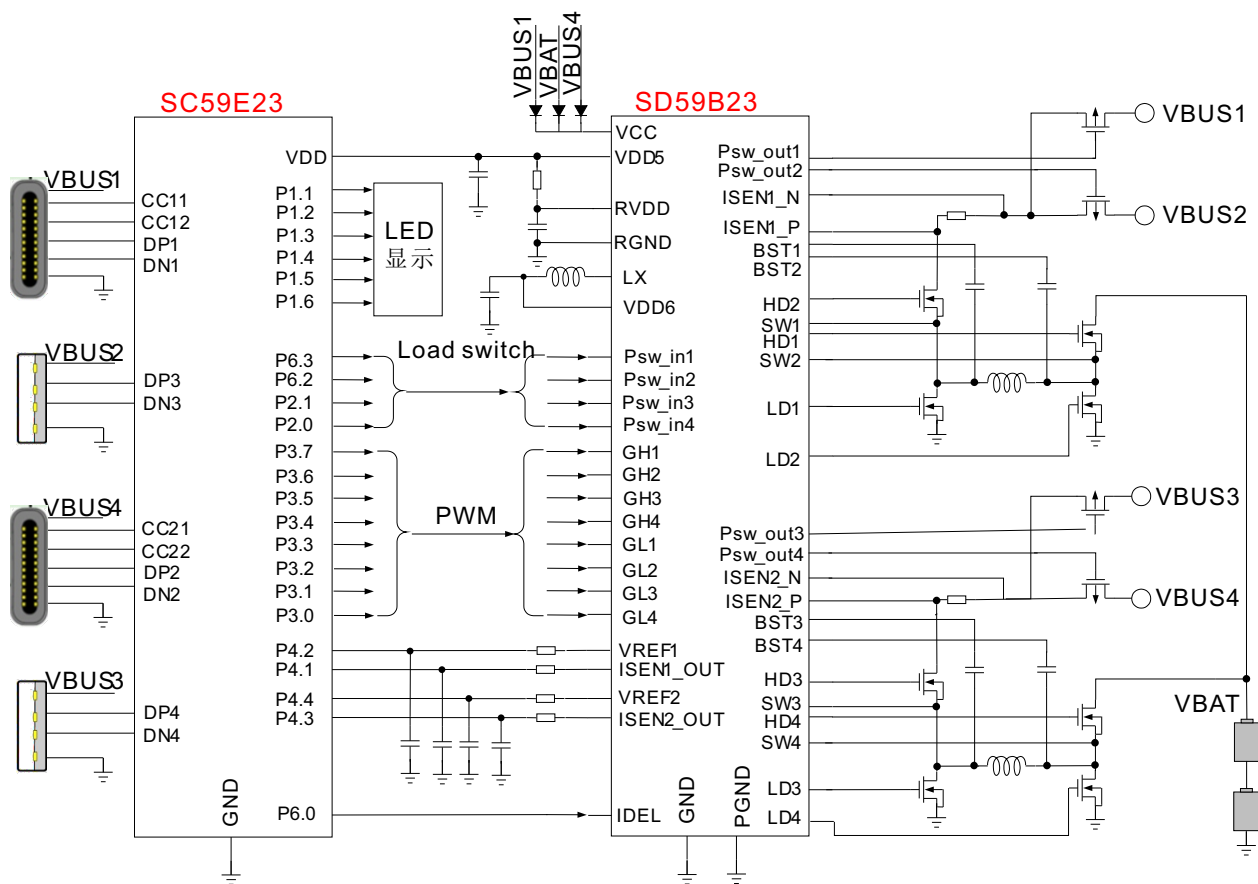
- 工作电压3.8~24V
- 极小待机电流30uA
- 集成1路LDO和1个Buck DC-DC
- 提供4个PMOS 负载开关控制
- 提供两路H桥的驱动
- 支持高达500kHz开关频率
- 内置专利的低失调运放支持正负电流采样
- QFN6*6-52封装

SC59E23

产品特点

- 支持2对CC口和4对DD口协议解析
- 快充协议支持PD3.0/QC3.0/SCP/FCP /APPLE/AFC/SFCP
- 8路死区可控的PWM信号
- 内置专利算法的数字PWM控制
- 支持LED显示功能
- 内置MCU，支持个性化的二次开发
- QFN6*6-52封装

典型应用原理图



SD59F21

产品特点

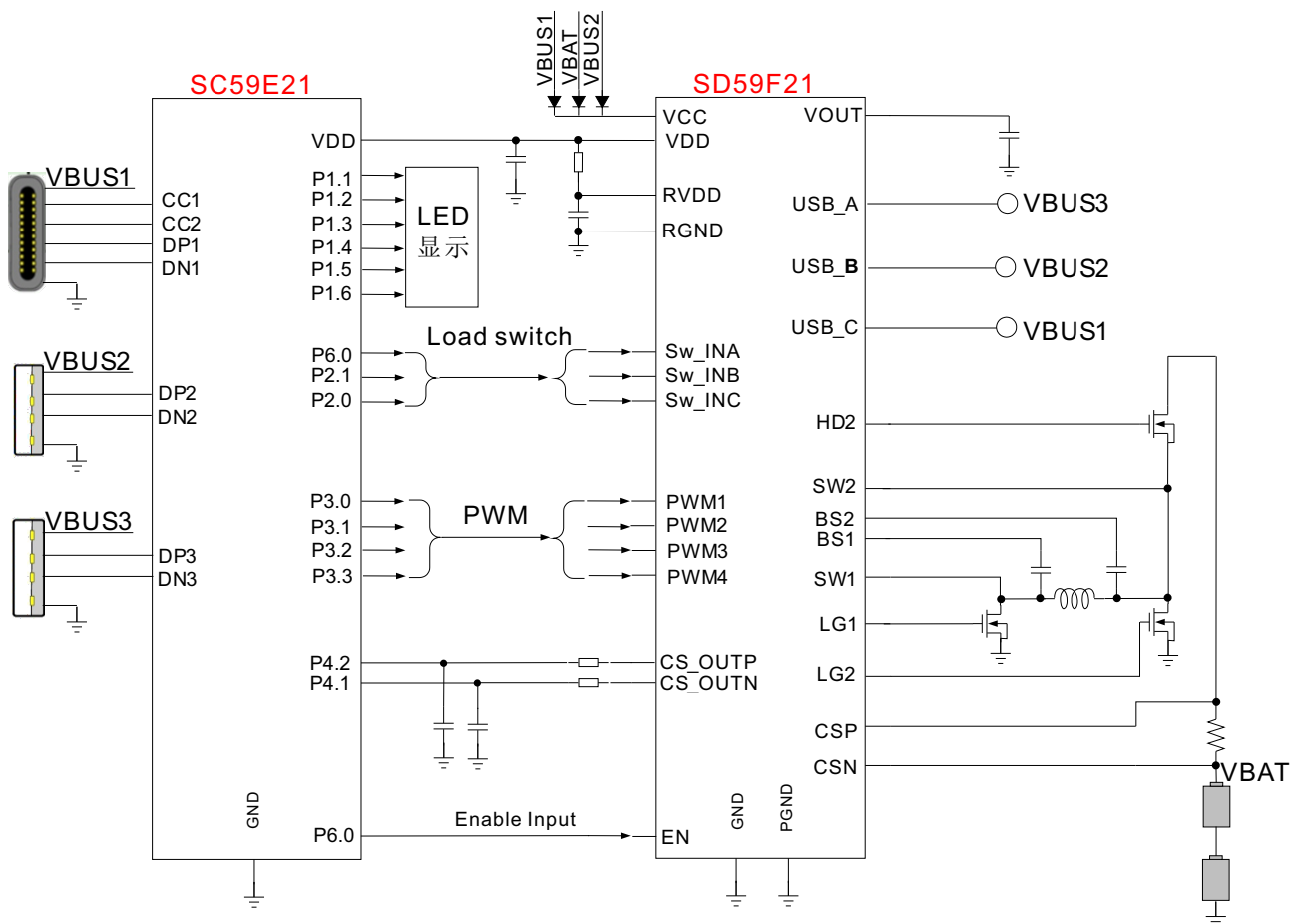
- ◎ 工作电压2.9~24V
- ◎ 集成1颗电源开关MOS和3颗负载开关MOS
- ◎ 集成一路LDO
- ◎ 内置专利的低失调运放支持正负电流采样
- ◎ 支持半桥快充和H桥快充方案
- ◎ 支持高达500kHz开关频率
- ◎ 支持18-60W功率
- ◎ QFN52-6*6封装

SC59E21

产品特点

- ◎ 支持1对CC口和3对DD口协议解析
- ◎ 快充协议支持PD3.0/QC3.0/SCP/FCP/Apple/AFC/SFCP
- ◎ 4路死区可控的PWM信号
- ◎ 内置专利算法的数字PWM控制
- ◎ 支持LED显示功能
- ◎ 内置MCU，支持个性化的二次开发
- ◎ QFN40-5*5封装

典型应用原理图



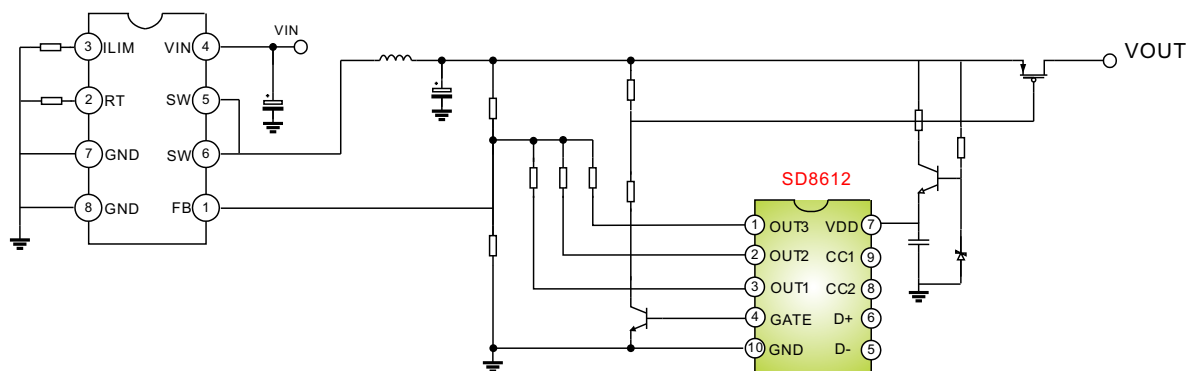
车充快充解决方案

SD8612

产品特点

- 支持PD 3.0/QC2.0/FCP/ Apple/AFC/SFCP
- 内置MCU，支持协议升级
- 通过FB调节电压，支持5V/9V/ 12V/20V输出
- 可以搭配第三方DC-DC
- SSOP10封装

典型应用原理图



杭州士兰微电子股份有限公司(总部)

Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd.

地址:杭州市黄姑山路4号

邮编Zip:310012

Add:No.4 HuangGuShan Road, HangZhou, China

电话Tel:86-571-88210880

网址Web:www.silan.com.cn



微信扫一扫
内容更丰富

销售及服务

周刚 手机13425194284 Email: gang.zhou@sz-xdx.com